

# Panier De Nettoyage Ptfé Pour Semi-Conducteurs, Support De Gravure Humide Pour Wafer De 12 Pouces, Résistant Aux Acides Et Alcalis, Porte-Substrat En Fluoropolymère

Numéro d'article: PL-CP81



## Introduction

Conçu pour les environnements semi-conducteurs à haute pureté, ce panier de nettoyage pour wafers PTFE de 12 pouces assure une résistance chimique exceptionnelle lors des processus critiques de gravure humide et de nettoyage. La conception personnalisée offre un support fiable pour le wafer et une exposition maximale aux fluides pour une fabrication de précision.

[En savoir plus](#)

Application	Description	Avantage clé
Nettoyage RCA	Séquence normalisée (SC-1 et SC-2) pour éliminer les contaminants organiques et les impuretés métalliques.	Empêche la recontamination lors des transitions pH élevé et pH faible.
Gravure HF	Élimination des couches d'oxyde sacrificiel ou des oxydes natifs à l'aide de solutions d'acide fluorhydrique.	L'immunité totale aux attaques HF assure la survie à long terme de l'équipement.
Gravure Piranha	Mélange à haute température d'acide sulfurique et de peroxyde d'hydrogène pour l'élimination de la résine photosensible.	Résiste aux réactions exothermiques extrêmes sans ramollissement structurel.
Rinçage post-CMP	Élimination des particules de boue et des produits chimiques suite au polissage mécano-chimique (CMP).	Les points de contact minimaux empêchent le piégeage de particules derrière le wafer.
Texturation de cellules solaires	Texturation acide ou alcaline de grands wafers de silicium pour améliorer l'absorption de la lumière.	Durabilité à haut volume dans les environnements d'exposition chimique continue.
Fabrication MEMS	Gravure humide profonde de substrats de silicium ou de verre pour créer des structures micromécaniques.	Assure des vitesses de gravure uniformes grâce à une circulation de fluide optimisée.
Photolithographie	Développement et décapage de matériaux de résine photosensible à l'aide de solvants organiques spécialisés.	Le matériau résistant aux solvants empêche la lixiviation d'organiques dans le révélateur.
Nettoyage mégasonique	Nettoyage acoustique à haute fréquence pour éliminer les particules sub-microniques des surfaces de wafers.	La densité du matériau transmet efficacement l'énergie acoustique sans effet d'amortissement.

Caractéristique	Détail de la spécification (PL-CP81)
<b>Matériau principal</b>	PTFE Vierge à haute pureté (Polytétrafluoroéthylène)
<b>Compatibilité du diamètre de wafer</b>	300 mm (12 pouces) - Tailles personnalisées disponibles sur demande
<b>Configuration</b>	Porte-wafer unique / Configuration panier fleur multi-wafers
<b>Processus de fabrication</b>	Usinage CNC de précision / Fabrication sur mesure
<b>Résistance chimique</b>	Pleine gamme (pH 0-14) ; résistant à HF, HNO3, HCl, H2SO4, KOH, etc.
<b>Température de fonctionnement</b>	Utilisation continue jusqu'à 260°C (Limites personnalisées basées sur la conception)

Application	Description	Avantage clé
Caractéristique	Détail de la spécification (PL-CP81)	
Pas / Espacement des fentes	Totalement personnalisable pour répondre aux exigences de débit ou de capacité	
Type de contact	Conceptions à contact ponctuel ou contact de bord disponibles	
Options de poignée	Interface fixe, amovible ou bride robotique automatisée	
Finition de surface	Finition usinée ultra-lisse pour minimiser l'adhérence des particules	
Norme de pureté	Conforme aux normes semi-conducteurs ; analyse des métaux traces disponible	